

Содержание

- XVII Межгосударственная конференция „Термоэлектрики и их применения — 2021“ (ISCTA 2021), Санкт-Петербург, 13–16 сентября, 2021

Япрынцева Е.Н., Иванов О.Н., Васильев А.Е., Япрынцев М.Н.

Микроструктура и термоэлектрические свойства среднеэнтропийных соединений $\text{BiSbTe}_{1.5}\text{Se}_{1.5}$ и PbSnTeSe , полученных реакционным искровым плазменным спеканием . . . 141

Грабов В.М., Урюпин О.Н.

Влияние дендритной неоднородности на термоэлектрические свойства кристаллов $\text{Bi}_{0.88}\text{Sb}_{0.12}$. . . 145

Демидов Е.В., Грабов В.М., Комаров В.А., Суслов А.В., Герега В.А., Крушельницкий А.Н.

Рост концентрации носителей заряда в тонких пленках висмута . . . 149

Ефимов Д.Д., Комаров В.А., Каблукова Н.С., Демидов Е.В., Старицын М.В.

Блочные и монокристаллические пленки сплава висмут–сурьма 3–12 ат% с подслоем сурьмы . . . 156

Иванов Д.К., Иванов К.Г., Урюпин О.Н.

Ленточный термоэлектрический генератор из углеродного волокна . . . 161

Elsehly E.M., El-Khouly A., Hassan Mohamed Asran, Новицкий А.П., Карпенков Д.Ю., Пашкова Д.С., Чеченин Н.Г., Uchimoto T., Miki H., Пархоменко Ю.Н., Ховайло В.В.

Влияние углеродных нанотрубок на термоэлектрические свойства сплавов Гейслера p - и n -типа . . . 164

Вейс А.Н., Лукьянова Л.Н., Усов О.А.

Оптическое поглощение, связанное с межзонными и межподзонными переходами электронов в теллуриде висмута 169

Макарова Е.С., Асач А.В., Тхоржевский И.Л., Фомин В.Е., Новотельнова А.В., Митропов В.В.

Исследование влияния технологических факторов на неопределенность результатов измерения теплопроводности методом лазерной вспышки . . . 173

Суслов А.В., Герега В.А., Грабов В.М., Демидов Е.В., Комаров В.А.

Деформация тонких пленок полуметаллов методом купольного изгиба подложки . . . 178

Сидоров А.В., Грабов В.М., Зайцев А.А., Кузнецов Д.В.

Влияние ионной подсистемы на термоэлектрический эффект в коллоидных растворах . . . 182

Суворова Е.И., Соломкин Ф.Ю., Архарова Н.А., Шаренкова Н.В., Исаченко Г.Н.

Микроструктура и фазовый состав сплава дисилицидов железа и хрома . . . 187

- Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)

Тыщенко И.Е., Хмельницкий Р.А., Сарайкин В.В., Володин В.А., Попов В.П.

Диффузия германия из захороненного слоя SiO_2 и формирование фазы SiGe . . . 192

- Электронные свойства полупроводников

Бахадираханов М.К., Зикриллаев Н.Ф., Исамов С.Б., Турекеев Х.С., Валиев С.А.

Влияние наличия достаточно высокой концентрации фосфора на концентрационное распределение галлия в кремнии . . . 199

- Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Дорофеев С.Г., Кононов Н.Н., Бубенов С.С., Попеленский В.М., Винокуров А.А.

Прыжковая проводимость Мотта и Эфроса–Шкловского в пленках из наночастиц Si , легированных фосфором и бором . . . 204

Уваров А.В., Шаров В.А., Кудряшов Д.А., Гудовских А.С.

Исследование влияния обработки поверхности Si -подложек на морфологию слоев GaP , полученных методом плазмохимического атомно-слоевого осаждения . . . 213

Давыдов С.Ю., Посредник О.В.

Электронные состояния атомов в монослоях, адсорбированных на карбиде кремния . . . 221

Лебедев А.А., Давыдов В.Ю., Елисеев И.А., Лебедев С.П., Никитина И.П., Оганесян Г.А., Смирнов А.Н., Шахов Л.В.

Исследование сильно легированных эпитаксиальных пленок n - 3C-SiC , выращенных методом сублимации на основе полуизолирующих подложек $6H\text{-SiC}$. . . 225

- Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Смагин В.П., Исаева А.А., Шелепова Е.А.

Влияние ионов неодима (III) на фотолюминесценцию сульфидов кадмия и цинка в полиакрилатной матрице . . . 229

● **Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники**

Парфенов П.С., Бухряков Н.В., Онищук Д.А., Бабаев А.А., Соколова А.В., Литвин А.П.

Исследование подвижности носителей заряда в слоях нанокристаллов PBS методом полевого транзистора 236

● **Физика полупроводниковых приборов**

Климов А.Э., Голяшов В.А., Горшков Д.В., Матюшенко Е.В., Неизвестный И.Г., Сидоров Г.Ю., Пашин Н.С., Супрун С.П., Терещенко О.Е.

МДП транзистор на основе пленки PbSnTe:In с подзатворным диэлектриком Al_2O_3 243

Александров О.В., Тяпкин Н.С., Мокрушина С.А., Фомин В.Н.

Влияние ионизирующего облучения на распределение зарядов и пробой МОП-транзисторов 250

Калинина Е.В., Кудояров М.Ф., Никитина И.П., Деметьева Е.В., Забродский В.В.

Облучение ионами аргона Cr/4H-SiC-фотоприемников . . . 254